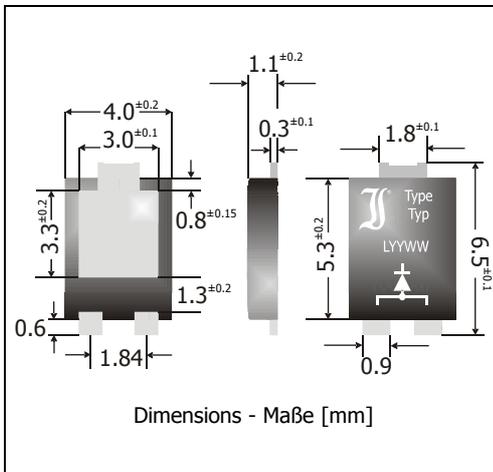


PPS560, PPS5100

Surface Mount Schottky Rectifier Diodes Schottky-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage

Version 2014-04-17



Nominal Current Nennstrom	5 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	60...100 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	PowerSMD
Weight approx. Gewicht ca.	0.1 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	 Green Molding Halogen-Free
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gurgert auf Rolle	

Features

AEC-Q101 (add suffix "-Q")
Compatible to industry standard packages

Vorteile

AEC-Q101 (ergänze Suffix „-Q“)
Kompatibel zu industrieeüblichen Gehäusen

Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Type Typ	Repet. / Surge peak rever. voltage Periodische- / Spitzen-Sperrspg. V_{RRM} [V] / V_{RSM} [V]	Forward Voltage Durchlass-Spannung V_F [V] $T_j = 125^\circ\text{C}^1)$		Forward Voltage Durchlass-Spannung V_F [V] $T_j = 25^\circ\text{C}^1)$	
		$I_F = 2\text{ A}$	$I_F = 5\text{ A}$	$I_F = 2\text{ A}$	$I_F = 5\text{ A}$
PPS560	60	tbd	tbd	< tbd	< 0.69
PPS5100	100	tbd	tbd	< tbd	< 0.88

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	20A ²⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	30 A ²⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	150/165 A ²⁾
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	112 A ² s ²⁾
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	-50...+150°C -50...+150°C

1 Both anode pins connected – Beide Anodenanschlüsse kontaktiert

Characteristics
Kennwerte

Leakage current Sperrstrom	PPS560	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R I_R I_R	typ. tbd μA < 150 μA typ. tbd mA
Leakage current Sperrstrom	PPS5100	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R I_R I_R	typ. tbd μA < 15 μA typ. tbd mA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht - Gehäuse				R_{thC}	< 2.0 K/W
Typical Junction Capacitance Typische Sperrschichtkapazität			$V_R = 4\text{ V}$	C_j	200 pF

